

C. Materials Growth & Characterization **분과**

Room F
창의관 (B114)

일 시 : 2월 17일(금) 13:40-15:10

세션명 : [FF3-C] Wide Bandgap Materials

좌 장 : 권순용(울산과학기술대학교), 송진동(KIST)

FF3-C-1 13:40-14:10 **[Invited]** Revisit on Dislocations and Related Defects in Heteroepitaxy:
Polar and Nonpolar GaN and ZnO Cases

저자: Soon-Ku Hong

소속: Department of Materials Science & Engineering and Graduate
School of Green Energy Technology, Chungnam National
University

FF3-C-2 14:10-14:25 **Fabrication of InGaN/GaN Green LED**

저자: 김성복¹, 배성범¹, 백주희¹, 윤두협¹, 임성목², 손정환², 문영부³,
김현성⁴, 김종배¹

소속: ¹한국전자통신연구원 광무선융합부품연구부, ²(주)제니컴, ³(주)더
리즈, ⁴한양대학교

FF3-C-3 14:25-14:40 **Improved Mobility of AlGaIn/GaN HEMT Structure on 6-inch
Silicon(111) by Bowing Parameter**

저자: 신종훈, 김준호, 김재무, 김광중, 장태훈

소속: LG 전자 Emerging 연구소 IGBT Part

FF3-C-4 14:40-14:55 **The Effect of Si Precursor on the Properties of Atomic Layer
Deposited HfSiO Film**

저자: 이승미, 김범용, 지연혁, 은용석, 김춘환, 홍권, 강효상

소속: Memory R&D Division, Hynix Semiconductor Inc.